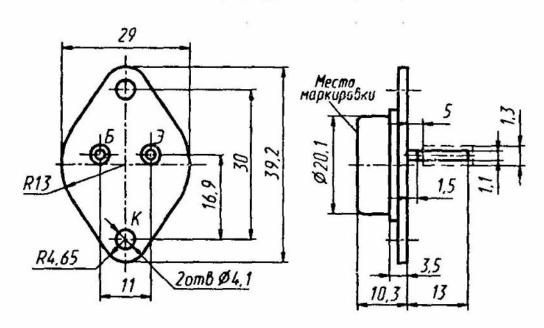
## 2T842A, 2T842B, 2T842A1, 2T842B1, KT842A, KT842B, KT842B

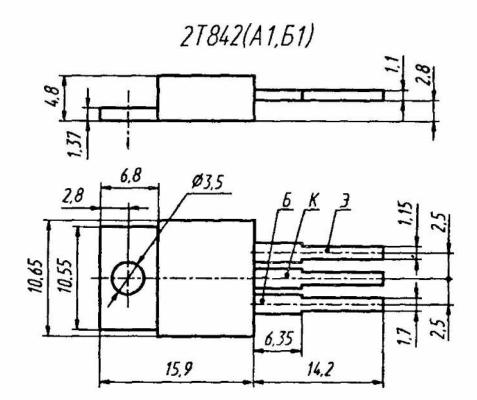
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *р-п-р* переключательные. Предназначены для применения в мощных преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения. Транзисторы 2Т842A, 2Т842Б, КТ842A—КТ842В выпускаются в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Транзистор 2Т842A1, 2Т842Б1 выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, в пластмассовом корпусе не более 2 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

## 2T842(A,5), KT842(A-B)





## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока	
в схеме ОЭ при $U_{K5} = 4$ В, $I_{3} = 5$ А, не менее:	
$T_{K} = +25  ^{\circ}\text{C}$ :	
2Т842А, 2Т842Б, КТ842А, КТ842Б	15
2Т842А1, 2Т842Б1	10
KT842B	20
$T_{K} = T_{K, MAKC}$ :	
2T842A, 2T842Б	15
2Т842А1, 2Т842Б1	6
$T_{\kappa} = -60  ^{\circ}\text{C}$ :	
" o (o - o	10
2Т842А1, 2Т842Б1	
Граничная частота коэффициента передачи	J
тока в схеме ОЭ, не менее:	
при $U_{K5} = 5$ В, $I_3 = 1$ А для 2Т842А,	
2T842B, KT842A, KT842B	20 МГц
при $U_{K5} = 10$ В, $I_3 = 0.2$ А для 2Т842А1,	
2Т842Б1	10 МГц
при $U_{K6} = 5$ В, $I_3 = 1$ А для KT842В	
Граничное напряжение при 4 = 50 мА,	3 N SS 55.
не менее:	
2T842A, 2T842A1, KT842A	250 B

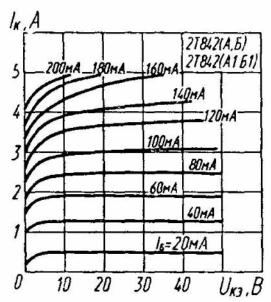
2Т842Б, 2Т842Б1, КТ842Б, КТ842В Напряжение насыщения коллектор—эмиттер	150 B
The contract of the contract o	40 D
при $I_{K} = 5$ A, $I_{5} = 1$ A, не более	1,8 B
типовое значение	0,5* B
для КТ842В	2,2 B
Напряжение насыщения база—эмиттер	
при $I_{K} = 5$ A, $I_{5} = 1$ A, не более	1,8 B
типовое значение	1,1* B
Время рассасывания при $U_{K3} = 20$ В, $I_{K} = 2$ А,	one of the same
/ <sub>5</sub> = 0,5 A, типовое значение:	
2Т842А, 2Т842Б, КТ842А, КТ842Б, КТ842В	0,8* мкс
2T842A1, 2T842Б1	2,2* MKC
	2,2 MKC
Время включения при $U_{K3} = 20$ В, $I_{K} = 2$ А,	
$I_6 = 0.5 \text{ A}$ , TUTOBOE SHAYEHUE:	0.40+
2T842A, 2T842B, KT842A, KT842B, KT842B	0,12* мкс
2T842A1, 2T842Б1	0,1* мкс
Время спада при $U_{K3} = 20$ В, $I_{K} = 2$ А,	
/ <sub>6</sub> = 0,5 A, типовое значение:	100 W 120
2Т842А, 2Т842Б, КТ842А, КТ842Б, КТ842В	0,13* мкс
2T842A1, 2T84251	0,3* mkc
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB, MAKC}$ ,	
не более:	
<i>T</i> = −60+25 °C	1 mA
$T = T_{MAKC}$	3 MA
$T = T_{MAKC}$	
$T = T_{MAKC}$	3 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	
Обратный ток эмиттера при $U_{35} = 5$ В, не более	3 MA 5 MA
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 MA 5 MA
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ анные
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ анные 300 В
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ анные 300 В
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ анные 300 В
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ анные 300 В
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ анные 300 В
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ анные 300 В
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ <b>анные</b> 300 В 200 В
Обратный ток эмиттера при $U_{36} = 5$ В, не более	3 мА 5 мА 400 пФ 250* пФ 3500 пФ 2400* пФ <b>анные</b> 300 В 200 В

2Т842Б, 2Т842Б1, КТ842Б, КТ842В	200 B
при <i>R</i> <sub>БЭ</sub> = ∞:	
2T842A, 2T842A1, KT842A	250 B
2Т842Б, 2Т842Б1, КТ842Б, КТ842В	150 B
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 B
Постоянный ток коллектора	5 A
Импульсный ток коллектора при $t_{\rm H} = 10$ мс	8 A
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 A
Импульсный ток базы при $t_{\rm H}$ = 10 мс	2 A
	2 /
Постоянная рассеиваемая мощность коллек-	
тора <sup>2</sup> :	
с теплоотводом, $T_{\rm K} = T_{\rm K, MWH}+25$ °C:	50 B
2Т842А, 2Т842Б, КТ842А, КТ842Б	50 Bτ
2Т842А1, 2Т842Б1	30 BT
KT842B	100 BT
без теплоотвода, $T_{K} = T_{K, \text{ мин}} + 25  ^{\circ}\text{C}$ :	
2Т842А, 2Т842Б, КТ842А, КТ842Б,	
KT842B	3 BT
2Т842А1, 2Т842Б1	1 BT
Температура <i>p-п</i> перехода:	
2T842A, 2T842B	+175 °C
2T842A1, 2T842B1, KT842A, KT842B,	
KT842B	+150 °C
Температура окружающей среды:	
2T842A, 2T8425	$-60T_{K} =$
	= +125°C
2Т842А1, 2Т842Б1	$-607_{K} =$
<u></u>	= +100°C
KT842A, KT842B, KT842B	$-45T_{K} =$
	= +100°C

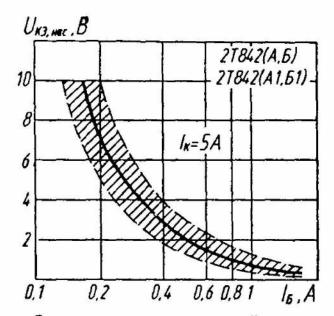
 $<sup>^2</sup>$  При  $T_{\rm K}$  > +25 °C максимально допустимая постояниая рассеиваемая мощность коллектора для 2Т842A, 2Т842Б снижается линейно на 0,33 Bt/°C с теплоотводом и на 20 мВт/°C без теплоотвода, для 2Т842A1, 2Т842Б1 соответственно на 0,24 Вт/°C и на 8 мВт/°С, для КТ842A, КТ842Б снижается линейно до 20 Вт с теплоотводом и до 1,2 Вт без теплоотвода при  $T_{\rm K}$  = +100 °C, для КТ842В до 40 Вт с теплоотводом и до 1,2 Вт без теплоотвода.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора. Транзисторы являются комплементарными с транзисторами 2Т841A, 2Т841B, 2Т841A1, 2Т841B1, КТ841A—КТ841B.

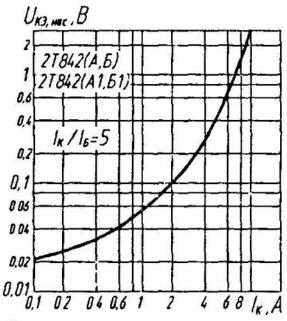
Зависимости электрических параметров транзисторов КТ842A, КТ842Б аналогичны зависимостям 2Т842A, 2Т842Б.



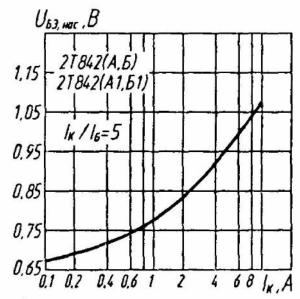
Выходные характеристики



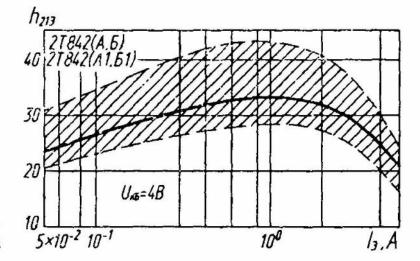
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор—змиттер от тока базы



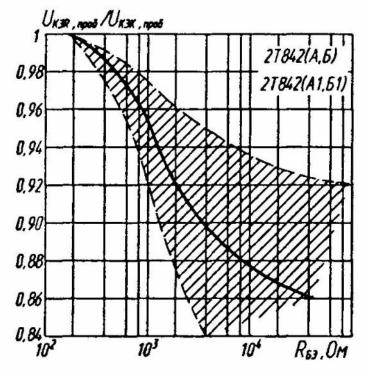
Зависимость напряжения насыщения коллектор— миттер от тока коллектора

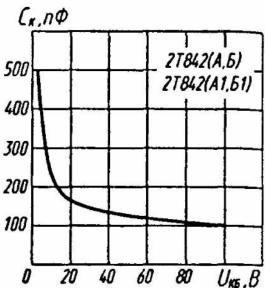


Зависимость напряжения насыщения база—змиттер от тока коллектора



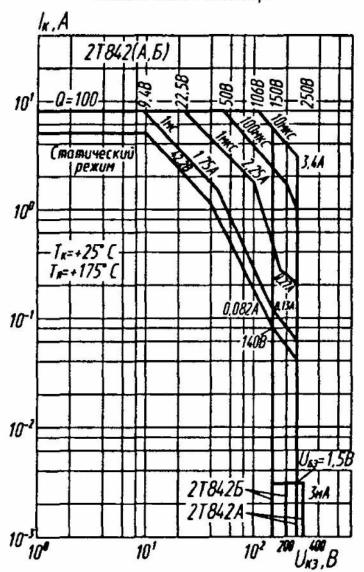
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера

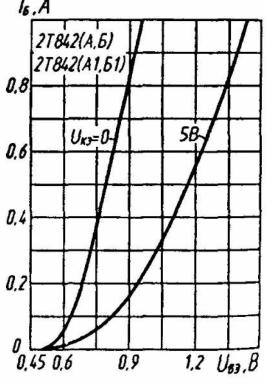




Зона возможных положений зависимости пробивного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер

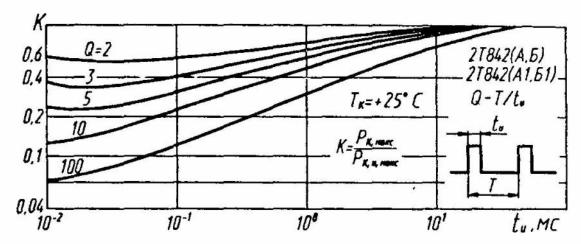
Зависимость емкости коллекторного перехода от иапряжения коллектор—база



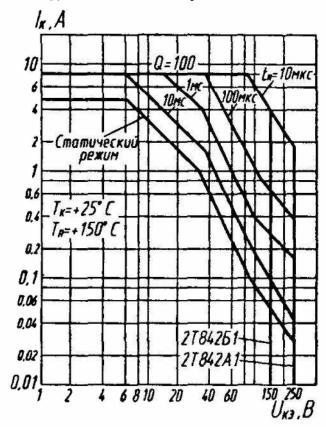


Входные характеристики

Области максимальных режимов



Зависимость коэффициента К от длительности импульса



Области максимальных режимов